2SC3658, 2SC3659

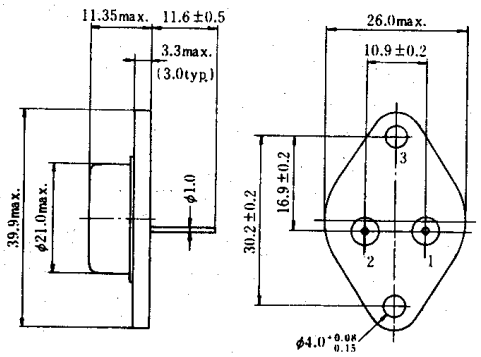
查询"2SC3659"供应商

シリコン NPN 三重拡散形

高電圧，大電力スイッチング用

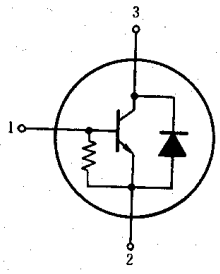
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE, HIGH POWER SWITCHING



(JEDEC TO-3)

1. ベース：Base
2. エミッタ：Emitter
3. コレクタ：Collector
(ケース) (Case)
(Dimensions in mm)

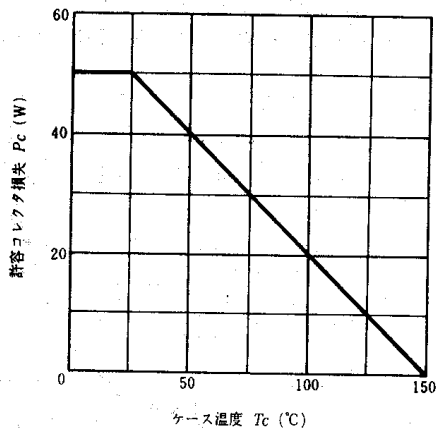


■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SC3658	2SC3659	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1500	1700	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	6	V
コレクタ電流	I_D	5	5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	6	6	A
ダイオード順方向電流	I_D	6	6	A
許容コレクタ損失	P_C*	50	50	W
接合部温度	T_j	150	150	℃
保存温度	T_{stg}	−45～+150	−45～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	2SC3658 min.	2SC3658 typ.	2SC3658 max.	2SC3659 min.	2SC3659 typ.	2SC3659 max.	Unit
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=1200V, I_E=0	—	—	500	—	—	—	μA
		V_{CB}=1400V, I_E=0	—	—	—	—	—	500	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	V_{EB}=6V, I_C=0	—	—	500	—	—	500	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=5A, I_B=1.25A*	—	—	2.0	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=5A, I_B=1.25A*	—	—	1.5	—	—	1.5	V
エミッタ・コレクタダイオード電圧	V_{ECF}	I_F=6A*	—	—	2.0	—	—	2.0	V
下降時間	t_f	I_C=5A, I_B=1A, I_{B2}=−2.5A, L_B=0	—	—	0.5	—	—	0.5	μs

*パルス測定
*Pulse Test